

石墨炔修饰的 ZnO 薄膜紫外探测器

黄志娟¹, 喻志农^{1,*}, 李言¹, 王吉政^{2,*}

¹北京理工大学光电学院, 北京市混合现实与新型显示工程技术研究中心, 北京 100081

²中国科学院化学研究所, 有机固体实验室, 北京 100190

ZnO Ultraviolet Photodetector Modified with Graphdiyne

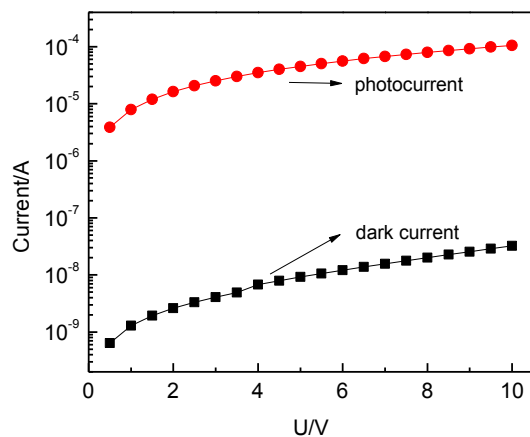
HUANG Zhijuan¹, YU Zhinong^{1,*}, LI Yan¹, WANG Jizheng^{2,*}

¹ Beijing Engineering Research Center of Mixed Reality and Advanced Display, School of Optoelectronics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, P. R. China.

² Key Laboratory of Organic Solids, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, P. R. China.

*Corresponding author. Email: znyu@bit.edu.cn (Y.Z.N.); jizheng@iccas.ac.cn (W.J.Z.).

图S1为石墨炔旋涂2次，沟道长为 $30\ \mu\text{m}$ ，宽为 $2000\ \mu\text{m}$ 的ZnO探测器的 I - V 曲线。在 $10\ \text{V}$ 偏压下，器件光电流为 $0.11\ \text{mA}$ ，暗电流为 $0.03\ \mu\text{A}$ 。



图S1 沟道宽 $30\ \mu\text{m}$ ，长 $2000\ \mu\text{m}$ 的ZnO探测器的 I - V 曲线

Fig. S1 I - V curves of the ZnO photodetectors, channel length is $30\ \mu\text{m}$ and width is $2000\ \mu\text{m}$.